

2SB709, 2SB709A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形 / Si PNP Epitaxial Planar

一般増幅用 / General Amplifier

2SD601, 2SD601A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SD601, 2SD601A

■ 特徴 / Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}
- ミニ型パッケージのため機器の小形化およびテーピング、マガジン包装による自動挿入が可能。
MINI Type package suitable for small equipment, tape and magazine types for automatic insertion are available.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-25	V
	2SB709A	-45	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-25	V
	2SB709A	-45	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-200	mA
コレクタ電流	I_C	-100	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_J	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	°C

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -20 V, I_E = 0$			-0.1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = -10 V, I_B = 0$			-100	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = -10 \mu A, I_E = 0$	-25			V
			-45			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -2 mA, I_B = 0$	-25			V
			-45			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = -10 \mu A, I_C = 0$	-7			V
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE} = -10 V, I_C = -2 mA$	160		460	
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = -10 V, I_E = 1 mA$		80		MHz
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -100 mA, I_B = -10 mA$	-0.3	-0.5		V
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = -10 V, I_E = 0, f = 1 MHz$		2.7		pF

* h_{FE} ランク分類 / h_{FE} Classifications

Class	Q	R	S
h_{FE}	160~260	210~340	290~460
Marking Symbol	2SB709 AQ	AR	AS
	2SB709A BQ	BR	BS

■ 形名表示記号(例) / Marking Symbol

